



ISSN 1813-8586

НАНО-И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА

- Нанотехнологии
- Зондовая микроскопия
- Микромашины и наносистемы
- Молекулярная электроника
- Биоактивные нанотехнологии
- Элементы датчиков и биочипы
- Микроэлектромеханические системы
- Микрооптоэлектромеханические системы
- Биомикроэлектромеханические системы

1 (150)
2013

Уважаемые читатели!

Редакционная коллегия и редакция журнала поздравляют вас с наступающим Новым 2013 годом!

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и творческих успехов!

2013

Январь

П 7 14 21 28
В 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
Ч 3 10 17 24 31
П 4 11 18 25
С 5 12 19 26
В 6 13 20 27

Февраль

П 4 11 18 25
В 5 12 19 26
С 6 13 20 27
Ч 7 14 21 28
П 1 8 15 22
С 2 9 16 23
В 3 10 17 24

Март

П 4 11 18 25
В 5 12 19 26
С 6 13 20 27
Ч 7 14 21 28
П 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24 31

Апрель

П 1 8 15 22 29
В 2 9 16 23 30
С 3 10 17 24
Ч 4 11 18 25
П 5 12 19 26
С 6 13 20 27
В 7 14 21 28

Май

П 6 13 20 27
В 7 14 21 28
С 1 8 15 22 29
Ч 2 9 16 23 30
П 3 10 17 24 31
С 4 11 18 25
В 5 12 19 26

Июнь

П 3 10 17 24
В 4 11 18 25
С 5 12 19 26
Ч 6 13 20 27
П 7 14 21 28
С 1 8 15 22 29
В 2 9 16 23 30

Июль

П 1 8 15 22 29
В 2 9 16 23 30
С 3 10 17 24 31
Ч 4 11 18 25
П 5 12 19 26
С 6 13 20 27
В 7 14 21 28

Август

П 5 12 19 26
В 6 13 20 27
С 7 14 21 28
Ч 1 8 15 22 29
П 2 9 16 23 30
С 3 10 17 24 31
В 4 11 18 25

Сентябрь

П 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24
С 4 11 18 25
Ч 5 12 19 26
П 6 13 20 27
С 7 14 21 28
В 1 8 15 22 29

Октябрь

П 7 14 21 28
В 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
Ч 3 10 17 24 31
П 4 11 18 25
С 5 12 19 26
В 6 13 20 27

Ноябрь

П 4 11 18 25
В 5 12 19 26
С 6 13 20 27
Ч 7 14 21 28
П 1 8 15 22 29
С 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24

Декабрь

П 2 9 16 23 30
В 3 10 17 24 31
С 4 11 18 25
Ч 5 12 19 26
П 6 13 20 27
С 7 14 21 28
В 1 8 15 22 29

Рисунок к статье И. А. Аверина, В. А. Мошникова, И. А. Пронина
**«Влияние типа и концентрации собственных дефектов
 на свойства структур диоксида олова»**

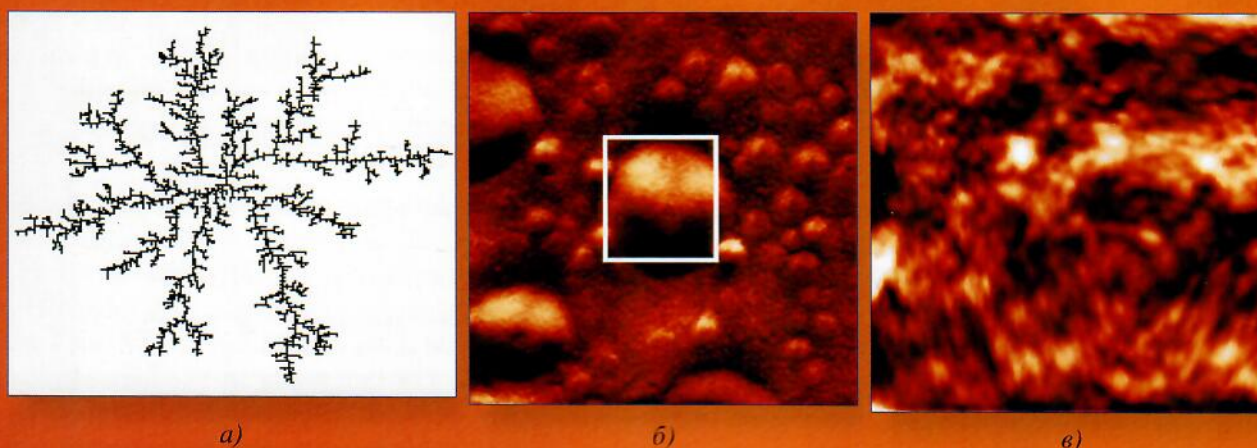


Рис. 2. Кластеры диоксида олова, полученные с помощью золь-гель-технологии:
 а – фрактальный агрегат Виттена – Сендера; б – морфология пленки $\text{SiO}_2 - \text{SnO}_2$;
 в – увеличенный участок кластера

Рисунок к статье К. А. Брехова, А. В. Кудрявцева, Н. А. Ильина.,
 Н. Э. Шерстюк, Е. Д. Мишиной
**«Переключение диэлектрической поляризации в сегнетоэлектрических
 мультислойных планарных структурах BST/NBFO»**

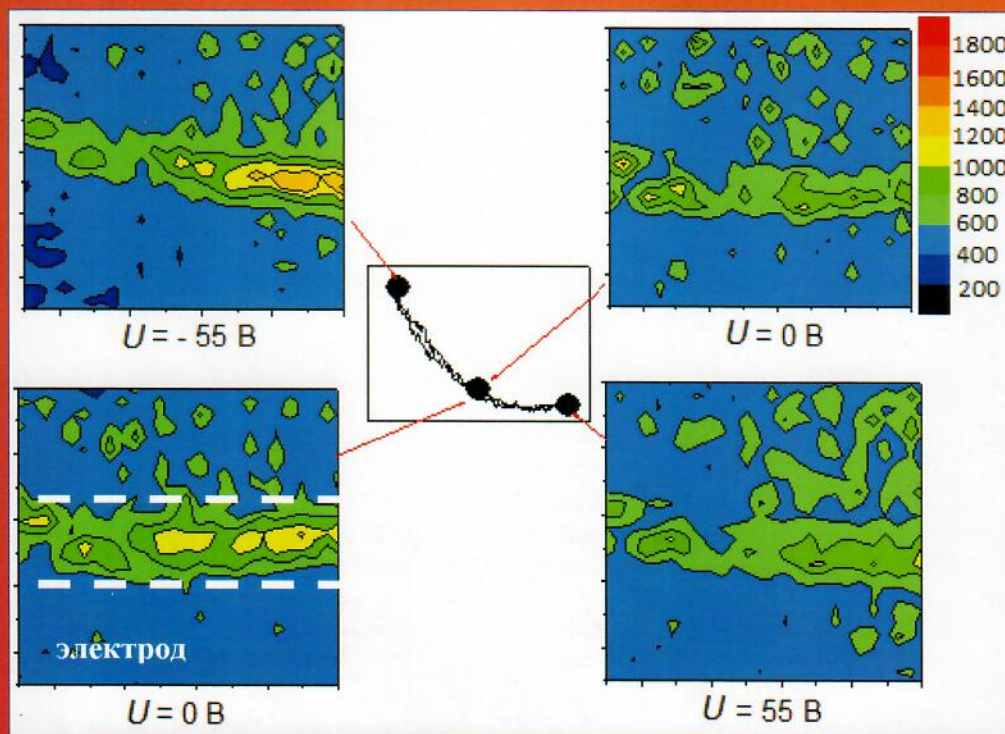


Рис. 4. Пространственное распределение сегнетоэлектрической поляризации в зазоре между электродами, полученное методом нелинейно-оптической микроскопии при приложении напряжения по схеме $+55 \text{ В} - 0 \text{ В} - -55 \text{ В} - 0 \text{ В}$. Размер изображения $100 \times 100 \text{ мкм}$. На вставке – области петли нелинейно-оптического гистерезиса, соответствующие изображениям. Штриховые линии показывают границы зазора

Рисунки к статье Р. А. Хабибуллина
«Технология создания наногетероструктур $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{In}_y\text{Ga}_{1-y}\text{As}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$
на арсениде галлия»

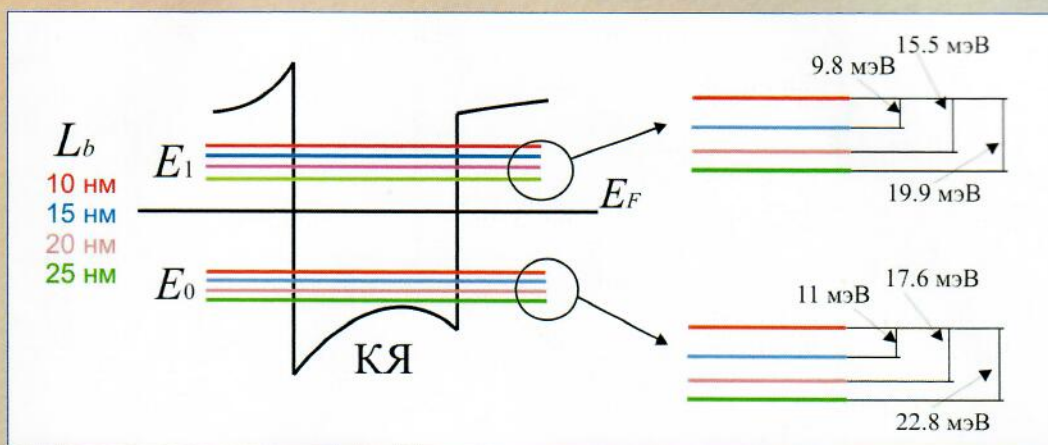


Рис. 1. Смещение двух уровней размерного квантования в КЯ при увеличении L_b

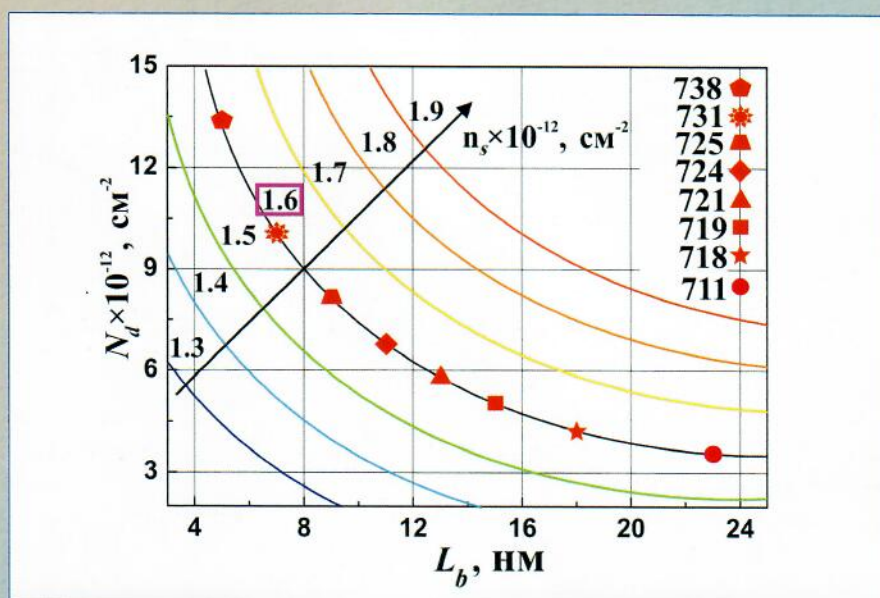


Рис. 3. Изолинии постоянной концентрации электронов в КЯ для образцов 711, 718, 719, 721, 724, 725, 731, 738

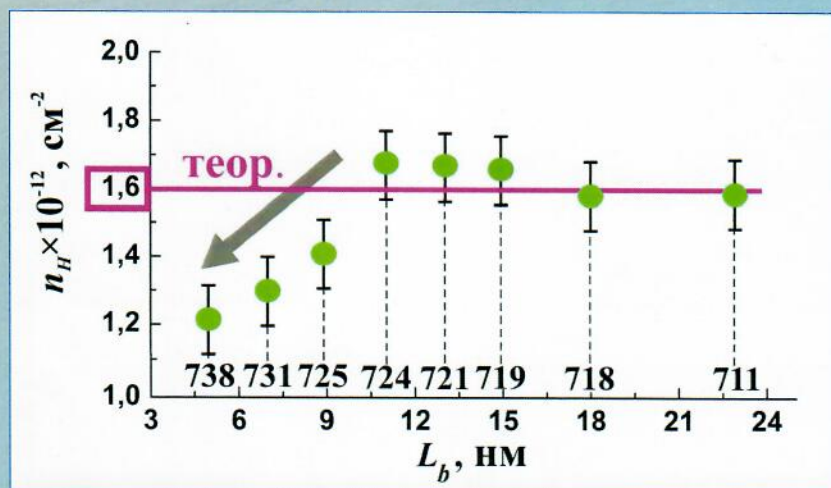


Рис. 5. Значения холловской концентрации электронов n_H для образцов 711, 718, 719, 721, 724, 725, 731 и 738 при комнатной температуре